

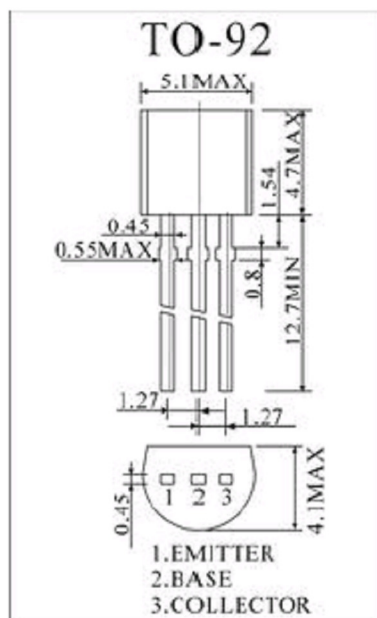
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors 8050

■ 主要用途：功率放大、开关等。

—NPN silicon—

■ 绝对最大额定值 (Ta=25°C)

项 目	符 号	额 定 值	单 位
集电极-基极电压	V _{CB0}	40	V
集电极-发射极电压	V _{CEO}	25	V
发射极-基极电压	V _{EB0}	6	V
集电极电流	I _c	1.5	A
集电极耗散功率	P _c	1	W
结 温	T _J	150	°C
存储温度	T _{stg}	- 55~150	°C



■ 电参数 (Ta=25°C)

项 目	符 号	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
直流电流增益	h _{FE}	85		300		V _{CE} = 1 V, I _c = 100 mA
集电极-基极截止电流	I _{CB0}			0.1	μ A	V _{CB} = 35 V, I _E =0
发射极-基极截止电流	I _{EB0}			0.1	μ A	V _{EB} = 6 V, I _c =0
集电极-基极击穿电压	BV _{CB0}	40			V	I _c = 0.1 mA, I _E =0
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	25			V	I _c = 2 mA, I _B =0
发射极-基极击穿电压	BV _{EB0}	6			V	I _B = 0.1 mA, I _c =0
集电极-发射极饱和压降	V _{CE(sat)}		0.28	0.5	V	I _c = 800 mA, I _B = 80 mA
基极-发射极饱和压降	V _{BE(sat)}		0.98	1.2	V	I _c = 800 mA, I _B = 80 mA
电流增益-带宽乘积	f _T	100			MHz	I _c = 50 mA, V _{CE} = 10 V
共基极输出电容	C _{ob}		9	20	PF	V _{CB} = 10 V, I _E =0, f = 1 MHz

■ h_{FE} 分档及其标志

分 档	B	C	D
h _{FE}	85~160	120~200	160~300